

Problema 2.1 (Características)

Considerar um transistor NMOS de reforço com $V_t = 2 \text{ V}$, o qual tem $i_D = 1 \text{ mA}$ quando $v_{GS} = v_{DS} = 3 \text{ V}$.

- (a) Calcular o valor de i_D quando $v_{GS} = 4 \text{ V}$ e $v_{DS} = 3 \text{ V}$.
- (b) Calcular a resistência r_{DS} quando $v_{GS} = 4 \text{ V}$ e $v_{DS} < 0.5 \text{ V}$.